

Diode II

tiefe Störstellen	deep impurities
Rekombinationszentren	recombination centers
Haftstelle	trap
Einfangkoeffizient	capture coefficient
Emissionsrate	emission rate
Minoritätsladungsträger- Lebensdauer	minority carrier lifetime
pn-Übergang	pn-junction
Idealitätsfaktor	ideality factor
Durchbruch	breakdown
Lawinendurchbruch	avalanche breakdown
Interband-Tunneln	band-to-band tunneling
Stossionisationsrate	impact ionization rate
Stossionisationskoeffizient	impact ionization coefficient

Schottky-Diode

Bildkraft	image force
Austrittsarbeit	work function
Elektronenaffinität	electron affinity
Grenzflächenzustände	interface states
Ohmscher Kontakt	Ohmic contact

Bipolar-Transistor

Basisweite	base width
Vorwärts-aktiver Modus	forward active mode
Rückwärts-aktiver Modus	reverse active mode
Sperrbereich	cut-off region
Emitterschaltung	common emitter circuit configuration
Basisschaltung	common base circuit configuration
Verstärkung	amplification
Oberflächen-Rekombinationsgeschwindigkeit	surface recombination velocity
Strom-Verstärkung	current gain
Kleinsignal	small signal
Emitter-Effizienz	emitter efficiency factor
Basis-Transportfaktor	base transport factor
Basisweiten-Modulation	base width modulation
Early-Spannung	Early voltage
Hochinjektion	high injection
Zeitverzögerungsfaktor	time delay factor
Durchgangszeit	transit time
Sperrschichtberührung, Durchgriff, Durchschlag	punch-through
Stromeinschnürung	current crowding
Aufladungszeit	charging time

MOS-Diode

MOS	Metal-Oxide-Semiconductor
MIS	Metal-Insulator-Semiconductor
Inversionsschicht	inversion layer
Inversionskanal	inversion channel
Akkumulationsschicht	accumulation layer
Schwelspannung	threshold voltage
Flachbandspannung	flat-band voltage
Grenzflächenladungen	interface charges
Niedrigfrequenz-Kapazität	low-frequency capacitance

MOSFET

FET	Field-Effect Transistor
Anreicherungstyp	enhancement type
Verarmungstyp	depletion type
Transfer-Kennlinie (= Eingangskennlinie)	transfer characteristics
Kanal-Beweglichkeit	channel mobility
induzierte (influenzierte) Ladung	induced charge
Abschnürpunkt (-region)	pinch-off point (region)
Sättigungsstrom	saturation current
Gegenwirableitwert	transconductance
Substratspannung	substrate (body, bulk) voltage
Vorspannung	bias
Überlapp-Kapazität	overlap capacitance
Eingangsimpedanz	input impedance
Grenzfrequenz	cutoff frequency
Kanallängen-Modulation	channel length modulation
Kurzkanal-Effekt	short-channel effect
Anstieg der Eingangskennlinie im Bereich unterhalb der Schwellspannung	subthreshold swing